



Toshiba bringt SiC-MOSFET-Modul mit 3300 V für Industrieanlagen auf den Markt

Hohe Pulsstromfestigkeit verbessert die Systemzuverlässigkeit

Düsseldorf, Deutschland, 6. Oktober 2026 – Toshiba Electronics Europe GmbH („Toshiba“) gab heute die Markteinführung des IX800FXF2YMS4 bekannt – ein dual SiC-MOSFET-Modul, mit dem das Produktportfolio erweitert wird. Das neue Modul bietet eine hohe Pulsstromfestigkeit und gewährleistet damit einen zuverlässigen Betrieb in Industrieanlagen. Dazu gehören Wechselrichter und Wandler für Schienenfahrzeuge sowie Stromumwandlungssysteme wie Halbleitertransformatoren, unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) und Energiespeichersysteme sowie industrielle Anlagen zur Motorsteuerung. Darüber hinaus trägt es durch reduzierte Leitungs- und Schaltverluste maßgeblich zur Verbesserung des Systemwirkungsgrads bei.

Das IX800FXF2YMS4 basiert auf Toshiba's verbesserter dritten Siliziumkarbid-(SiC)-MOSFET Generation. Das Modul ist mit einer Drain-Source-Spannung (V_{DS}) von 3300 V und einem Drain-Gleichstrom (I_D) von 800 A geratet.

Das neue IX800FXF2YMS4 weist für seine Diode einen I^2t -Wert von 300 kA²s auf (gemessen bei einer anfänglichen Kanaltemperatur von 175 °C, $V_{GS} = -6$ V, einen einzelnen Halbsinusimpuls von 10 ms und einer Ausfallrate (FR) von 1 %). Dadurch ist die Pulsstromfestigkeit der Diode auch unter außergewöhnlichen Betriebsbedingungen garantiert. Ein optimiertes SiC-MOSFET-Design ermöglicht diese Leistungsfähigkeit und verbessert auf Systemebene die Zuverlässigkeit der Anlagen.

Zudem führen die geringen Leitungs- und Schaltverluste des Moduls zu einem höheren Wirkungsgrad der Anlagen und können dazu beitragen, den Kühlbedarf zu senken. Die typische Drain-Source-Spannung im leitenden Fall (Sense) ($V_{DS(on)sense}$) beträgt 1,4 V bei $I_D = 800$ A, $V_{GS} = +20$ V und $T_{ch} = 25$ °C. Die typischen Schaltverluste beim Ein- und Ausschalten (E_{on} und E_{off}) betragen 185 mJ bzw. 175 mJ bei $V_{DD} = 1800$ V, $I_D = 800$ A und $T_{ch} = 175$ °C.

Das neue Produkt ist im iXPLV™-Gehäuse (Intelligent Flexible Package Low Voltage) untergebracht. Dieses nutzt Silbersintern (Ag) zur Die-Befestigung, um sowohl die Hitzebeständigkeit als auch die Zuverlässigkeit zu maximieren, und unterstützt eine Kanaltemperatur von bis zu 175 °C. Mit diesem Neuzugang erweitert Toshiba das Angebot an SiC-MOSFET-Modulen im iXPLV-Gehäuse auf insgesamt vier Produkte.

Toshiba wird sein Sortiment an SiC-MOSFET-Modulen für Industrieanlagen auch in Zukunft kontinuierlich ausbauen. Ziel ist es, ein breites Spektrum an Produktoptionen anzubieten, um den vielfältigen Anlagenspezifikationen und Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Damit leistet Toshiba weiterhin einen wichtigen Beitrag zu robusteren, effizienteren und kompakteren Industrieanlagen.

Weitere Informationen über das neue SiC-MOSFET-Modul IX800FXF2YMS4 finden Sie auf der Website von Toshiba: <https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/mosfets/sic-mosfet-modules/detail.IX800FXF2YMS4.html>

Klicken Sie auf den folgenden Link, um mehr über die SiC-Leistungshalbleiter von Toshiba zu erfahren
[Power Semiconductors | Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation | Europe\(EMEA\)](#)

###

Hinweise für die Redaktion:

* iXPLV ist eine Marke der Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation.

Über Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) bietet Verbrauchern und Unternehmen in Europa eine große Auswahl an Festplattenlaufwerken (HDDs) sowie Halbleiterlösungen für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Industrie, IoT, Bewegungssteuerung, Telekommunikation, Netzwerke, Consumer und Haushaltsgeräte. Neben HDDs umfasst das Angebot auch Leistungshalbleiter und andere diskrete Bauelemente von Dioden bis hin zu Logik-ICs, Optoelektronik sowie Mikrocontrollern/MCUs und anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs). Darüber hinaus bietet TEE auch SCiB™-Batteriezellen und -Module mit Lithium-Titan-Oxid (LTO) für Hochleistungsanwendungen.

TEE hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland, und verfügt über Niederlassungen in Frankreich, Italien, Spanien, Schweden und Großbritannien, die Marketing-, Vertriebs- und Logistikdienstleistungen anbieten.

Weitere Unternehmens- und Produktinformationen finden sich auf den Websites von Toshiba unter www.toshiba.semicon-storage.com und www.scib.jp/en.

Ansprechpartner für Veröffentlichungen:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland

Tel: +49 (0) 211 5296 0

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

Ansprechpartner für die Presse:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)7464 493526

E-Mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Herausgegeben durch:

Birgit Schöniger, Pretzl

Tel: +49 (0)172 617 8431

Web: www.pretzl.com

E-Mail: birgit.schoeniger@pretzl.com

Oktober 2026

Ref. 7709(A)G